This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paper of Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. V& THA 10/604,352 **Application Number** TRANSMITTAL 07/14/2003 **Filing Date** Min-Hsun Hsieh **FORM First Named Inventor Group Art Unit** (to be used for all correspondence after initial filing) **Examiner Name** Attorney Docket Number KYCP0009USA Total Number of Pages in This Submission 3 **ENCLOSURES** (check all that apply) After Allowance Communication **Assignment Papers** Fee Transmittal Form (for an Application) to Group **Appeal Communication to Board** Fee Attached Drawing(s) of Appeals and Interferences **Appeal Communication to Group Licensing-related Papers** Amendment / Reply (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Petition After Final **Proprietary Information** Petition to Convert to a Affidavits/declaration(s) **Provisional Application Status Letter** Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Other Enclosure(s) (please **Extension of Time Request** Address identify below): **Terminal Disclaimer Express Abandonment Request** Request for Refund **Information Disclosure Statement** CD, Number of CD(s) _ **Certified Copy of Priority** Document(s) Remarks Response to Missing Parts/ **Incomplete Application Response to Missing Parts** under 37 CFR 1.52 or 1.53 SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT Firm Winston Hsu, Reg. No.: 41,526 or Individual name

CE	RTIFICATE OF MAILING				
hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class nail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date:					
Typed or printed name					
Signature	Date				

1 motor Hay 8729) 2003

Signature

Date

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

SEP 0. 3 7003 334

PTO/SB/17 (01-03)

Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

FEE TRANSMITTAL for FY 2003

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00

Complete if Known					
Application Number	10/604,352				
Filing Date	7/14/2003				
First Named Inventor	Min-Hsun Hsieh				
Examiner Name					
Art Unit					
Attorney Docket No.	KYCP0009USA				

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)				FEE	E CALCULATION (continued)		
Check Credit card Money Other None 3. ADDITIONAL FEES							
Deposit Account:	Large E	ntity	Small	Entity			
Denosit	Fee Code			Fee (\$)	Fee Description	See Deid	
Account Number 50-0801	1051	130	2051		Surcharge - late filing fee or oath	Fee Paid	
Deposit North America International Patent Office	1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or		
Account North America international Patent Office					cover sheet		
The Commissioner is authorized to: (check all that apply)	1053	130	1053	** **	Non-English specification For filing a request for ex parte reexamination		
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812						
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application	1804	920*	1804	920	Requesting publication of SIR prior to Examiner action		
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action		
FEE CALCULATION	1251	110	2251	55	Extension for reply within first month		
1. BASIC FILING FEE	1252	410	2252	205	Extension for reply within second month		
Large Entity Small Entity	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month		
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid Code (\$) Code (\$)	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month		
1001 750 2001 375 Utility filing fee	1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month		
1002 330 2002 165 Design filing fee	1401	320	2401	160	Notice of Appeal		
1003 520 2003 260 Plant filing fee	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal		
1004 750 2004 375 Reissue filing fee	1403	280	2403	140	Request for oral hearing		
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding		
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable		
	1453	1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1501	1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)		
Extra Claims below Fee Paid	1502	470	2502	235	Design issue fee		
Total Claims X = X =	1503	630	2503	315	Plant issue fee		
Claims - 3" =	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner		
Multiple Dependent =	1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)		
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Description	1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt		
Fee Fee Fee <u>Fee Description</u> Code (\$) Code (\$)	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)		
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20	1809	750	2809	375	Filing a submission after final rejection		
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3					(37 ČFR 1.129(a))		
1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid	1810	750	2810	375	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))		
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims over original patent	1801	750	2801	375			
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20	1802	900	1802	900			
and over original patent					of a design application	 	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other f		–		·		
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Redu	ced by	Basic f	riling F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00		
SUBMITTED BY					(Complete (if applicable)		
NAC	D	ogistra	tion No				

SUBMITTED BY							(Complete	e (if applicable)	
Name (Print/Type)	Winston Hsu	1	Registration No. 41,526		Telephone 886289237350				
Signature	4		ine	lon	1 Har	4	Date	8/29/	2003

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

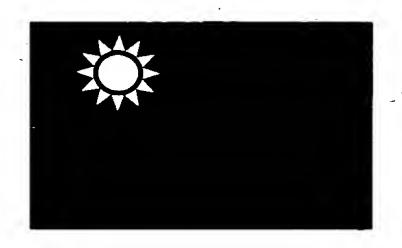


Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)		Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
091114587	Taiwan, R.O.C.	07/15/2002		
	~			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.





中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛, 其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 清 日: 西元 2002 年 07 月 15 日

Application Date

申請案號: 091114587

Application No.

申 請 人: 晶元光電股份有限公司

Applicant(s)-

一局

長

Director General







發文日期: 西元 <u>2003</u> 年 <u>6</u> 月 <u>12</u> 日

Issue Date

發文字號: 09220575580

Serial No.



申請日期:	案號:	
類別:		

(以上各欄由本局填註)

·		發明專利說明書
	中文	具有黏結層之發光二極體及其製法
發明名稱	英 文	
	姓 名 (中文)	1. 謝明勳 2. 曾子峯 3. 劉文煌 4. 葉丁瑋
二 、 發明人	姓 名 (英文)	1. 2. 3. 4.
. 12-	國籍 在、居所	4.新竹科學工業園區園區一路40號
	· 姓 名 (名稱) (中文)	1. 晶元光電股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	
三申請人	國籍 住、居所 (事務所)	1. 前竹科學工業園區園區二路48號
	代表人姓 名(中文)	1. 禁實夫
	代表人姓 名 (英文)	1.

申請日期:	案號:	······································	
類別:			
		•	

(以上各欄由本局填註)

·		發明專利說明書
	中文	
發明名稱	英文	
	姓名(中文)	5. 王仁水
二 、 發明人	姓名(英文)	5.
		5. 中華民國 5. 新竹科學工業園區園區二路48號
	住、居所	
	姓 (名稱) (中文)	
	姓 (名稱) (英文)	
三三	國 籍	
三、申請人	住、居所 (事務所)	
	代表人 姓 名 (中文)	
	代表人 姓 名 (英文)	
min w.e.k.r.sk/2	ለመጥ በህክትና <u>የ</u> ትን	

四、中文發明摘要 (發明之名稱:具有黏結層之發光二極體及其製法)

一種具有黏結層之發光二極體及其製法,其藉由一黏結層將一發光二極體疊層及一透明基板黏結在一起,其中黏結層之上下表面分別存在一反應層,以避免黏結層產生剝離,使得光線能夠由透明基板射出帶出,以提高發光二極體之亮度。

英文發明摘要 (發明之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期 案號

主張優先權

有關微生物已寄存於

寄存日期

寄存號碼

五、發明說明 (1)

本發明係關於一種發光二極體及其製法,尤其關於一種具有黏結層之發光二極體及其製法。

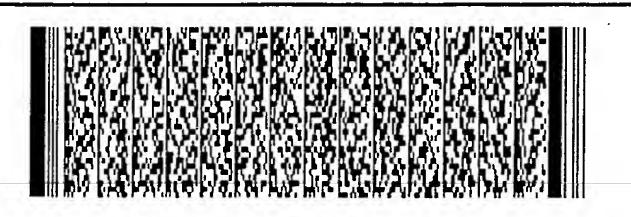
發光二極體之應用頗為廣泛,例如,可應用於光學顯示裝置、交通號誌、資料儲存裝置、通訊裝置、照明裝置、以及醫療裝置。如何提高發光二極體之亮度,是在發光二極體之製造上之重要課題。

於中華民國專利公告第474094號揭露一種發光二極體 及其製法,利用一透明絕緣黏接層,將一發光二極體疊層 與一透明基板接合在一起。由於該方法為利用凡德瓦爾作 用力將兩半導體材料鍵結在一起,其缺點為凡德瓦爾鍵結 力太弱,鍵結後結構之機械強度不夠,容易產生剝離的情 況。

本案發明人於思考如何解決前述之缺點時,獲得一發明靈感為若藉使用一透明黏結層連結前述之發光二極體疊層與透明基板,其中該發光二極體疊層之黏結層之黏結層之黏結層之黏結層之黏結層之關之體,使得兩反應層外經過加壓加溫作用,使得兩反應層與或離子鍵,形成強大之鍵結內部結層反應,產生氫離的問題。

發明概要

本發明之主要目的在於提供具有黏結層之發光二極體 及其製法,在其製程中,藉使用一透明黏結層,連結一發





五、發明說明 (2)

光二極體疊層與基板,其中該發光二極體疊層與該透明黏結層之黏結層之黏結極與該透明基板與該透明都結層之黏結層,將發光二極體疊層、第一反應層以及透明基板疊合,將發光二極體疊合,第一反應層以及透明基板疊合,經過上級。

該發光二極體之製法包含下列步驟:在一第一基板上依次形成一第二接觸層、一第二束縛層、一發光層、一第一束縛層、一第一反應一束縛層、一第一是觸層、一第二基板上形成一第一反應層,構成一第二疊層; 選擇一透明黏結層, 利用該透明黏結層將該第一疊層之第二反應層表面以及該第二疊層之第



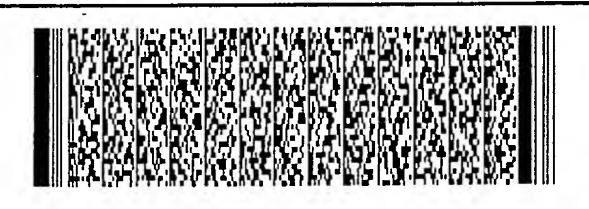


五、發明說明 (3)

一反應層表面結合在一起;移除該第一基板,構成一第三疊層;將該第三疊層適當地蝕刻至該透明導電層,形成一透明導電層暴露表面區域;以及在該第二接觸層層與該透明導電層暴露表面區域上分別形成第一接線電極與第二接線電極。

前述第一基板,係包含選自於GaP、GaAs及Ge所構成 材料組群中之至少一種材料;前述第二基板,係包含選自 SiC、A1203、玻璃、石英、GaP、GaAsP及A1GaAs所構成材. 料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料;前述透明 黏 結 層 係 包 含 選 自 於 聚 醯 亞 胺(PI)、 苯 并 環 丁 烷(BCB)或 過 氟 環 丁 烷(PFCB) 所 構 成 材 料 組 群 中 之 至 少 一 種 材 料 ; 前 述第一反應層係包含選自於SiNx、Ti或Cr所構成材料組群 中之至少一種材料;前述第二反應層係包含選自於SiNx、 Ti或Cr所構成材料組群中之至少一種材料;前述第一接觸 層係包含選自於GaP、GaAs、GaAsP、InGaP、AlGaInP及 AlGaAs所構成材料組群中之至少一種材料;前述第一束縛 層、發光層與第二束縛層,係包含AlGaInP;前述第二接 觸層,係包含選自於GaP、GaAs、GaAsP、InGaP、AlGaInP 及AlGaAs所構成材料組群中之至少一種材料;前述透明導 電層包含選自於氧化銦錫、氧化鎘錫、氧化銻錫、氧化 鋅、氧化鋅錫BeAu、GeAu及Ni/Au所構成材料組群中之至 少一種材料。

詳細說明





五、發明說明 (4)

請參閱圖I,依本發明一較佳實施例具有黏結層之發 光二極體I,包含一第二基板10、形成於該基板上之一第 一反應層11、形成於該第一反應層上之一透明黏結層12、 形成於該透明黏結層上之一第二反應層22、形成於該第一反應層上之一第二反應層22、形成於該第一 反應層上之一透明導電層21,其中,該透明導電層之一 表面區域上之一第二表面區域、形成於該第一接觸層13、形成於該第一接觸層上之一發光層15、 形成於該發光層上之一第二束縛層上之一發光層15、 形成於該發光層上之一第二束縛層16、形成於該第二束縛層上之一第二接觸層17、形成於該第二接觸層上之一等 接線電極19、以及形成於該第二表面區域上之一第二接線電極20。

請參閱圖1與圖2,發光二極體1之製法包含下列步驟:在一第一基板18上依次形成一第二接觸層17、一第二束縛層16、一發光層15、一第一束縛層14、一第一接觸層13、一透明導電層21、一第二反應層22,構成一第一疊層2;在一第二基板10上形成一第一反應層11,構成一第二疊層3,如圖3所示;選擇一透明黏結層12,利用該透明黏結層12,利用該透明黏結層於第一疊層之第二反應層表面以及該第二疊層之第二反應層表面以及該第二疊層4,如圖4所示;移除該第一基板18,構成一第四疊層5,如圖5所示;將該第四疊層5適當地蝕刻至該透明導電層21,形成一透明導電層暴露表面區域;以及在該第二接觸層17與該透明導電層暴露表面區域上分別形成第一接線電極19與第二接





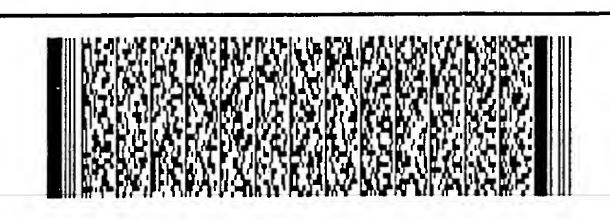
五、發明說明 (5)

線電極20。

前述第一基板,係包含選自於GaP、GaAs或Ge所構成 材料組群中之至少一種材料;前述第二基板,係包含選自 SiC、A1203、玻璃、石英、GaP、GaAsP及A1GaAs所構成材 料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料;前述透明 黏結層係包含選自於聚醯亞胺(PI)、苯并環丁烷(BCB)或 過氟環丁烷(PFCB)所構成材料組群中之至少一種材料;前 述第一反應層係包含選自於SiNx、Ti或Cr所構成材料組群 之至少一種材料;前述第二反應層係包含選自於SiNx、 Ti或Cr所構成材料組群中之至少一種材料;前述第一接觸 層係包含選自於GaP、GaAs、GaAsP、InGaP、AlGaInP或 AlGaAs所構成材料組群中之至少一種材料;前述第一束缚 層、發光層與第二束縛層,係包含AlGaInP;前述第二接 觸層,係包含選自於GaP、GaAs、GaAsP、InGaP、AlGaInP 或AlGaAs所構成材料組群中之至少一種材料;前述透明導 電層包含選自於氧化銦錫、氧化鎘錫、氧化锑錫、氧化 鋅、氧化鋅錫、BeAu、GeAu及Ni/Au所構成材料組群中之 至少一種材料。

雖然本發明之發光二極體已以較佳實施例揭露於上,然本發明之範圍並不限於上述較佳實施例,應以下述申請專利範圍所界定為準。因此任何熟知此項技藝者,在不脫離本發明之申請專利範圍及精神下,當可做任何改變。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明:

圖1為一示意圖,顯示依本發明一較佳實施例之一種 具有黏結層之發光二極體。

圖2為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光二極體之程序中,於黏結二疊層前之第一疊層。

圖3為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光二極體之程序中,於黏結二疊層前之第二疊層。

圖4為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光二極體之程序中,於黏結第一疊層及第二疊層後,但尚未移除第一基板前之第三疊層構造。

圖5為一示意圖,顯示依本發明製法製造圖1所示發光二極體之程序中,於移除第一基板後之第四疊層構造。

符號說明

1	發	光		極	體
1 0	第	_	基	板	
1 1	第		反	應	層
1 2	透	明	黏	結	層
1 3	第		接	觸	層
1 4	第		束	縛	層
1 5	發	光	層		
1 6	第		束	縛	層



圖式簡單說明

17 第二接觸層

18 第一基板

19 第一接線電極

20 第二接線電極

21 透明導電層

22 第二反應層



1. 一種具有黏結層之發光二極體之製法,至少包含下列步驟:

選擇一第一基板;

形成一LED疊層於該第一基板上;

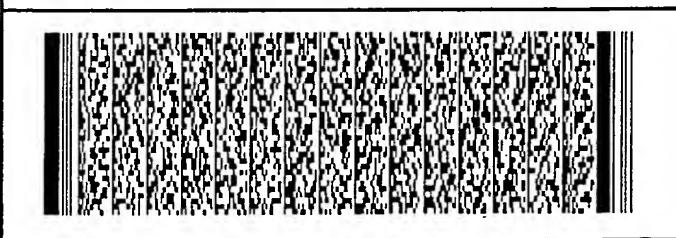
形成一第一反應層於該第一基板上;

選擇一第二基板;

形成一第二反應層於該第二基板上;

利用一透明黏結層將該LED疊層上之第一反應層以及該第二基板上之第二反應層結合在一起。

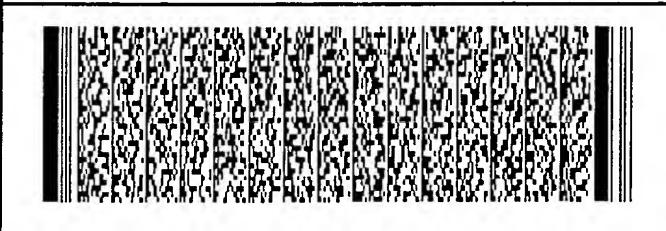
- 2. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該第一基板係包含選自GaP、GaAs或Ge所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。
- 3. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該第二基板係包含選自SiC、A1203、玻璃、石英、GaP、GaAsP及A1GaAs所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。
- 4. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該透明黏結層係包含選自於聚醯亞胺(PI)、苯并環丁烷(BCB)或過氟環丁烷(PFCB)所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。。



- 5. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該第一反應層係包含選自於SiNx、Ti或Cr所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。
- 6. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該第二反應層係包含選自於SiNx、Ti或Cr所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。
- 7. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,更包含在該第二基板上,形成第二反應層前, 形成一半導體疊層。
- 8. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,更包含形成LED疊層之後,於LED疊層上形成一透明導電層。
- 9. 如申請範圍第1項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,更包含移除該第一基板。
- 10.如申請範圍第8項所述之具有黏結反射層之發光二極體之製法,其中,該透明導電層包含選自於氧化銦錫、氧化錦錫、氧化錦錫、氧化鋅錫、GeAu、BeAu或Ni/Au所構成材料組群中之至少一種材料。



- 11. 一種具有黏結層之發光二極體,至少包含:
 - 一基板;
 - 一第一反應層,形成於該基板之上;
 - 一透明黏結層,形成於該第一反應層之上;
 - 一第二反應層,形成於該透明黏結層之上;
 - 一LED疊層,形成於該第二反應層之上;以及電極。
- 12. 如申請範圍第11項所述之具有黏結層之發光二極體,其中,更包含於第二反應層及LED疊層之間形成一透明導電層。
- 13.如申請範圍第12項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該透明導電層包含選自於氧化銦錫、氧化鍋錫、氧 化錦錫、氧化鋅、氧化鋅錫、GeAu、BeAu或Ni/Au所構成 材料組群中之至少一種材料。
- 14. 如申請範圍第11項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該基板係包含選自SiC、A1203、玻璃、石英、 GaP、GaAsP及A1GaAs所構成材料組群中之至少一種材料或 其它可代替之材料。
 - 15. 一種具有黏結層之發光二極體,至少包含:



一基板;

形成於該基板上之一第一反應層;

形成於該第一反應層上之一透明黏結層;

形成於該透明黏結層上之一第二反應層;

形成於該第二反應層上之一透明導電層,其中,該透明導電層之上表面包含一第一表面區域與一第二表面區域;

形成於該第一表面區域上之一第一接觸層;

形成於該第一接觸層上之一第一束縛層;

形成於該第一束縛層上之一發光層;

形成於該發光層上之一第二束縛層;

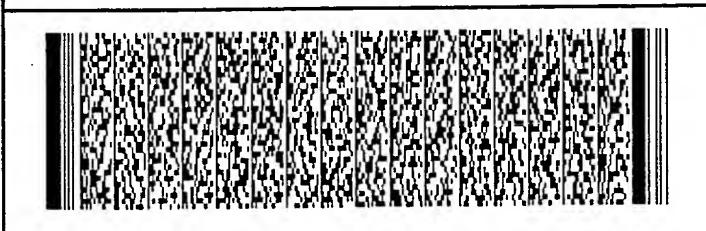
形成於該第二束縛層上之一第二接觸層;

形成於該第二接觸層上之一第一接線電極;以及

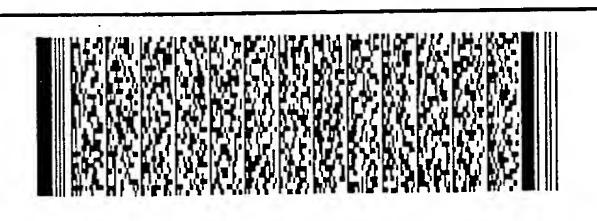
形成於該第二表面區域上之一第二接線電極。

16.如申請範圍第15項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該基板係包含選自SiC、A1203、玻璃、石英、 GaP、GaAsP及A1GaAs所構成材料組群中之至少一種材料或 其它可代替之材料。

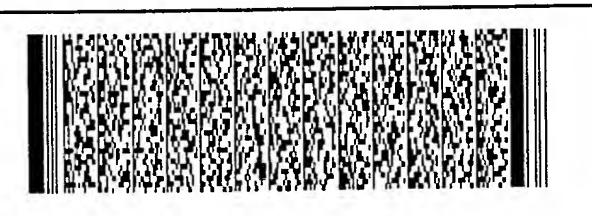
17. 如申請範圍第11項或第15項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該透明黏結層係包含選自於聚醯亞胺(PI)、苯并環丁烷(BCB)或過氟環丁烷(PFCB)所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。。

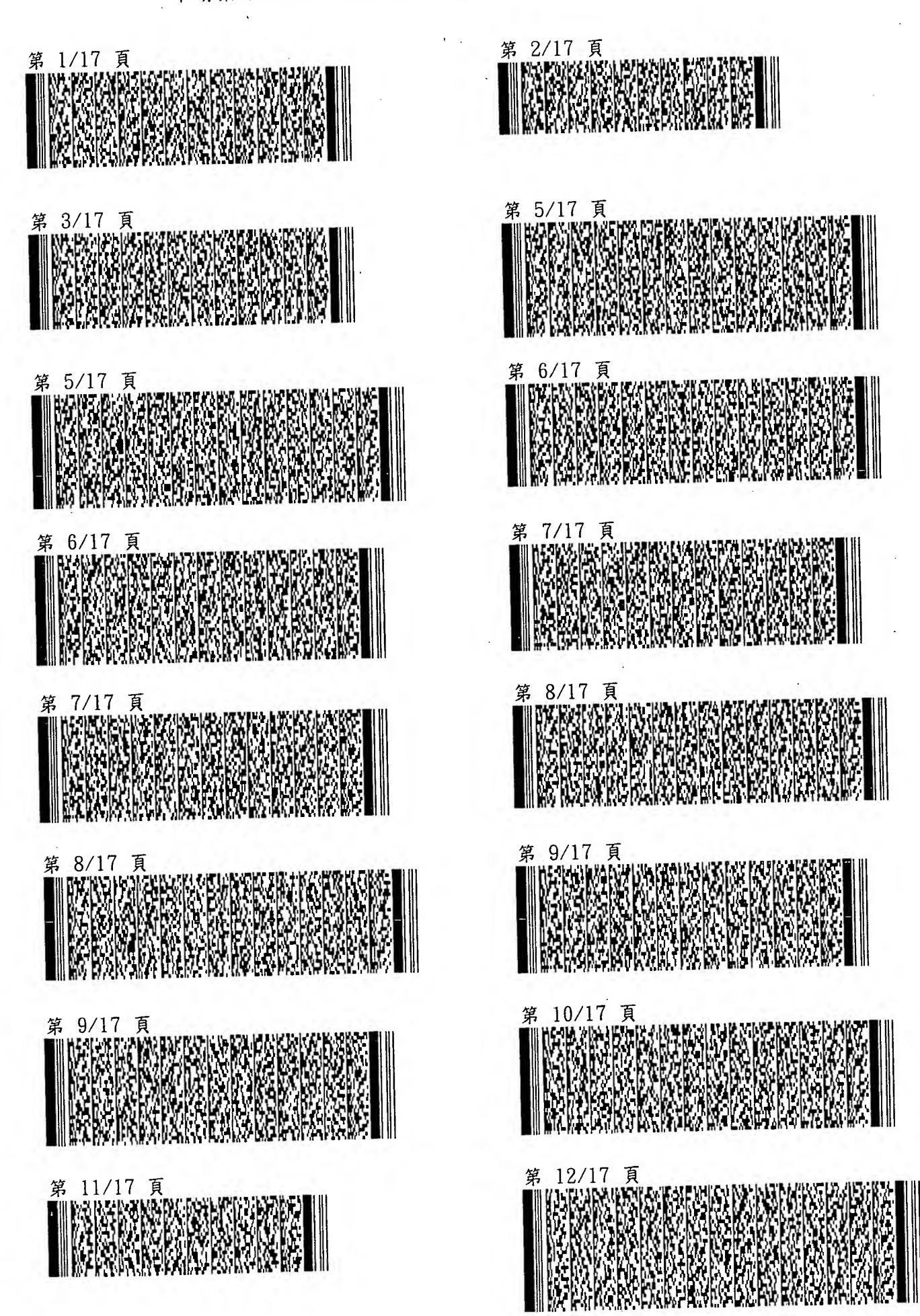


- 18. 如申請範圍第11項或第15項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該第一反應層係包含選自於SiNx、Ti或Cr所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。
- 19. 如申請範圍第11項或第15項所述之具有黏結層之發光二極體之製法,其中,該第二反應層係包含選自於SiNx、Ti或Cr所構成材料組群中之至少一種材料或其它可代替之材料。
- 20. 如申請範圍第15項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該第一接觸層係包含選自於GaP、GaAs、GaAsP、 InGaP、A1GaInP及A1GaAs所構成材料組群中之至少一種材料。
- 21. 如申請範圍第15項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該第一束縛層包含AlGaInP。
- 22. 如申請範圍第15項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該發光層包含A1GaInP。
- 23. 如申請範圍第15項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該第二束縛層包含A1GaInP。



- 24. 如申請範圍第15項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中,該第二接觸層係包含選自於GaP、GaAs、GaAsP、 InGaP、A1GaInP或A1GaAs所構成材料組群中之至少一種材料。
- 25. 如申請範圍第15項所述之具有黏結層之發光二極體, 其中可包含在該第二接觸層之上,第二接線電極之下形成 一透明導電層。
- 26. 如申請範圍第25項所述之具有黏結層之發光二極體,其中,該透明導電層包含選自於氧化銦錫、氧化鎘錫、氧化錦錫、氧化鋅錫、GeAu、BeAu或Ni/Au所構成材料組群中之至少一種材料。





申請案件名稱:具有黏結層之發光二極體及其製法

